



ワイドバンドギャップ半導体ーバルク結晶成長最前線ー

◇ 日時: 2022年11月18日(金) 10:30~17:40

◇ 場所: 名古屋大学 東山キャンパス ES 総合館1F ES ホール

カーボンニュートラル実現に向けて、パワーエレクトロニクスの果たすべき役割は大きい。中でもワイドバンドギャップ半導体への期待は益々高まっているが、その普及には、高品質、低コストな結晶成長技術が不可欠である。本研究会では、SiC、GaN、Ga₂O₃、ダイヤモンドなど材料横断で結晶成長技術の最新動向を共有し、今後の課題と展望について議論する。

プログラム

10:30~10:40 開会の挨拶

10:40~11:20 β -Ga₂O₃ バルク・ウェハー開発の現状

渡辺 信也((株)ノベルクリスタルテクノロジー)

11:20~12:00 ダイヤモンドウェハ作製技術開発

山田 英明(産業技術総合研究所)

12:00~13:00 休憩

13:00~13:40 酸性アモナーマル法による GaN 結晶成長

三川 豊(三菱ケミカル(株))

13:40~14:20 Na フラックス法による大口径高品質 GaN 結晶育成

森 勇介(大阪大学)

14:20~15:00 HVPE 法による GaN 成長技術の進展

藤倉 序章((株)サイオクス(現:住友化学(株)))

15:00~15:20 休憩

15:20~16:00 昇華法による SiC 結晶成長での欠陥制御と伝導度制御

江藤 数馬(産業技術総合研究所)

16:00~16:40 高温ガス成長法による SiC 結晶成長の高速化と高品質化

神田 貴裕((株)ミライズテクノロジーズ)

16:40~17:20 8インチに向けた SiC 溶液成長の開発

宇治原 徹(名古屋大学)

17:20~17:40 総括、閉会の挨拶

■ 参加受付: WEB 参加受付システム([ここをクリック*](#))から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai23.pdf> よりアクセスして下さい。

■ 参加費(消費税込):

先進パワー半導体分科会会員 4,000 円、分科会学生会員 1,000 円、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■ **感染症対策**: 事前の検温にご協力頂き、発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。また、会場入り口での再度の検温にご協力下さい(体温が37.5度以上ある場合、ご参加頂けません)。会場では、消毒およびマスクの常時着用をお願い致します。

問合せ先: (各種手続きに関するお問い合わせは応用物理学会事務局までお願いします)

金村 高司 (株)ミライズテクノロジーズ	e-mail: takashi.kanemura.j4y@mirise-techs.com
東脇 正高 (大阪公立大学)	e-mail: higashiwaki@omu.ac.jp
原田 俊太 (名古屋大学)	e-mail: shunta.harada@nagoya-u.jp
菊田 大悟 (豊田中央研究所)	e-mail: kikuta-d@mosk.tytlabs.co.jp
※白石 陽子 (応用物理学会事務局)	e-mail: shiraishi@jsap.or.jp